NM 22.10.25

Z poprzedniego wykładu

XRD: dyfraktogram, równanie Scherraera - im większa szerokość połówkowa piku tym mniejszy rozmiar krystalitu

TEM/SEM: zależność Abbe'go -> limit mikroskopii optycznej

STM/AFM: STM - materiały przewodzące, AFM - nie muszą być przewodząc

Czas życia luminescencji;

Wykład

Zasada działania lasera, akcja laserowa - emisja spontaniczna Właściwości światła laserowego:

- 1. mała rozbieżność wiązki
- 2. duża spójność wiązki monochromatyczność
- 3. moc promieniowania i gęstość energii

Techniki otrzymywania, część 1

- Z góry na dół (top down) obróbka jednorodnego kawałka materiału w celu uzyskania nanostruktur
 - skrawanie
 - mielenie młynki molekularne: zespoły tarcz o różnych konfiguracjach oraz kulki (1-2 mm średnicy). Procesy:
 - 1. Odkształcenia sprężyste
 - 2. Odkształcenia plastyczne
 - 3. Zniszczenie, amorfizacja

Wzrastają właściwości elektrostatyczne co prowadzi do aglomeracji. Rozwiązaniem tego problemu jest mielenie w mediach ciekłych np. alkoholach. Aby zapobiec ścieraniu kulek wykonywane są z **tlenki cyrkonu**. Zalety:

- prostota jednoetapowość
- brak skomplikowanych reakcji chemicznym
- stosunkowo duża wydajność i powtarzalność

Wady:

- zanieczyszczenie materiału kulami mielącymi
- uszkodzenia powierzchni i struktury nanomateriałów
- brak precyzyjnej kontroli rozmiaru
- brak możliwości otrzymania struktur rdzeń-płaszcz
- brak możliwość funkcjonalizacji powierzchni podczas syntezy
- kruszenie
- laserowa ablacja cechy:
 - używanie lasera femtosekunodwego
 - możliwość zmiany długości fali lub mocy lasera
 - możliwość doboru rozpuszczalnika i czasu naświetlania
 - zaleta: wysoka czystość nanomateriałów
 - wada: koszt lasera (kilka milionów PLN)
- fotolitografia (nano-fotolitografia) -wytrawianie warstwy tlenku krzemu na krzemie produkcja tranzystorów. Potrzeba postępu w produkcji doprowadziła do powstania fotolitografii elektronowej (zależność Abbe'go granica stosowalności światła). W dalszej obróbce tranzystorów używamy epitaksji.